




	<h2 style="color: red;">FQD13N06LTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD13N06LTM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 11A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD13N06LTM.pdf 2.FQD13N06LTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 47343 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD13N06LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 11A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	47343 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 11A (Tc) 2.5W (Ta), 28W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	115 mOhm @ 5.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD13N06LTM-ND

FQD13N06LTM ist neu im Original, Suche FQD13N06LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD13N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD13N06LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD13N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N06L-E3 Original TO-252</p>	 <p>FQD13N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A DPAK</p>	 <p>FQD13N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>
 <p>FQD13N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N06LTM-NL FAIRCHILD FQD13N06LTM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD13N06L FAIRCHILD FQD13N06L FAIRCHILD</p>	 <p>FQD13N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD11P06-NL	↔ FQD11P06TF	⇒ FQD11P06TF	D FQD11P06TM	↕ FQD11P06TM
⊕ FQD12N10	⊕ FQD12N20	D FQD12N20L	⇒ FQD12N20LTF	↕ FQD12N20LTF
⊕ FQD12N20LTM	⊕ FQD12N20LTM	⊕ FQD12N20TF	↔ FQD12N20TF	↕ FQD12N20TM
D FQD12N20TM	⊕ FQD12P10	⊕ FQD12P10TF	⊕ FQD12P10TF	↕ FQD12P10TM
⇒ FQD12P10TM	↔ FQD13N06	⊕ FQD13N06L	⊕ FQD13N06LTF	↕ FQD13N06LTF
↔ FQD13N06LTM	⇒ FQD13N06LTM-NL	D FQD13N06TF	⊕ FQD13N06TF	⊕ FQD13N06TM
⊕ FQD13N06TM	D FQD13N10	⇒ FQD13N10L	↔ FQD13N10LTF	↕ FQD13N10LTF
⊕ FQD13N10LTM	⊕ FQD13N10LTM	↔ FQD13N10LTM-NL	⇒ FQD13N10TM	↕ FQD13N10TM
⊕ FQD13N20D	⊕ FQD14N15	⊕ FQD16N15	D FQD16N25C	↕ FQD16N25CTM
↔ FQD16N25CTM	⊕ FQD16N25L	⊕ FQD17N08	⊕ FQD17N08L	↕ FQD17N08LTF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

